

明細書

熱処理装置及びその校正方法

技術分野

[0001] 本発明は、半導体ウエハ等の被処理体を熱処理する熱処理装置の校正方法に関し、特に、収容している被処理体の温度を熱モデルを用いて予想し、予想結果に基づいて制御を行う熱処理装置の熱モデルを校正する方法に関する。

背景技術

[0002] 多数の半導体ウエハに対して成膜処理、酸化処理あるいは拡散処理などの熱処理を一括して行うバッチ式熱処理装置においては、成膜すべき薄膜の種類および膜厚などに応じて、処理温度、処理圧力およびガス流量などの処理条件が決められており、これら処理条件を書き込んだレシピが用意されている。そして、各オペレータが薄膜の種類及び膜厚に応じたレシピを選択することにより、予め定められた処理条件に基づいて熱処理装置が運転される。

[0003] 热処理装置は、処理温度、処理圧力およびガス流量などの処理条件がレシピに定められた目標値に一致させるように制御しながら、処理を行う。これらの処理を適切に行うため、ウエハの温度、加熱炉内の圧力およびガス流量などを測定する必要がある。

[0004] 加熱炉内の圧力は圧力計により、ガス流量は供給管に配置された流量計を含むマスフローコントローラ等により、比較的正確に測定が可能である。しかし、ウエハの温度については、測定が困難である。例えば、ウエハに温度センサを装着して加熱炉内に収納する手法も考えられるが、温度センサ装着箇所に半導体素子を形成することができず、さらに、温度センサからの不純物が加熱炉内全体を汚染し、半導体装置の歩留まりを低下させる虞がある。

[0005] これらの問題を解決できる技術が、日本国特許公報JP2002-25997A及び米国特許US5,517,594明細書に開示されている。この技術は、加熱炉に複数の温度センサを配置し、この温度センサの出力と、ヒータへの供給電力などに基づいて、熱モデル(数学モデル)を用いてウエハの温度を刻一刻と予想し、予想値を用いて、ヒ

ータ電力を制御する技術である。この技術によれば、ウエハの温度を比較的正確に非接触で予想して、熱処理装置を制御することができる。

[0006] 上記装置の熱モデルは、以下のようにして設定される。まず、基本となる装置(基本装置)について熱モデル(基本モデル)を生成する。生成した基本モデルを、同一構造の装置に適用する。次に、基本装置と個々の装置との微妙な機差(個体差)を吸収するため、セットアップ作業を行う。この作業は、セットアップ用の成膜作業を個々の装置で行い、成膜された膜厚と目的とする膜厚との差異から熱モデルを補正し、機差によらず均一な膜、すなわち装置間で同一の厚さの膜を形成できるようにするものである。

[0007] 基本装置と個々の装置との差異は、熱に関するものだけではなく、ガスの流量やガスの圧力などについても、存在している。換言すれば、装置間では、圧力計やガス流量計の測定値のばらつきがある。

[0008] しかし、従来のセットアップ手法では、このような熱以外の要因による機差も全て熱モデルで吸収して、装置間の個体差をみかけ上なくして、装置間で同一の膜が形成されるようにしている。このようなセットアップ手法は、装置間に存在する差異点を細かく分析することなく、実質的に均一な仕様を得ることができ、非常に有効なセットアップ手法である。

[0009] しかしながら、従来のセットアップ手法では、場合により、装置の熱的な状況がかえって分かりづらくなってしまう場合があった。例えば、熱モデルで機差を吸収できないような場合には、プロセス結果のばらつき(例えば、成膜処理における膜厚のばらつき)の原因が装置のどの部分にあるのかわからなくなってしまうという問題があった。換言すれば、個々の装置の熱特性が正確には、わからなかつた。

発明の開示

[0010] 本発明は、このような事情の下に成されたものであり、熱モデルを用いて被処理体の温度を予想し、予想した温度に基づいて、熱処理を行う熱処理装置において、より正確な温度の予想を可能とすることを目的とする。

また、本発明は、熱モデルを用いて被処理体の温度を予想し、予想した温度に基づいて熱処理を行う熱処理装置において、より正確な温度特性の把握を可能とする

ことを他の目的とする。

[0011] 上記目的を達成するため、この発明の第1の観点に係る熱処理装置の校正方法は

、
被処理体を収容する処理容器と複数のヒータと複数の温度センサとを備え、前記温度センサの出力から前記処理容器内の被処理体の温度を推定するための熱モデルを記憶し、前記温度センサの出力から、該熱モデルを用いて、前記処理容器内の被処理体の温度を予想し、予想した温度に基づいて前記ヒータを制御することにより、前記被処理体に熱処理を施す熱処理装置の校正方法であって、

前記ヒータを駆動して、前記処理容器内を加熱する工程と、

前記処理容器内の前記被処理体の温度を測定する工程と、

測定した前記処理容器内の温度と、前記熱モデルを用いて予想した前記被処理体の温度とを比較し、実測値に予想値が実質的に一致するように前記熱モデルを校正する工程と、

を備えることを特徴とする。

[0012] 上記の方法によれば、熱モデルをその熱処理装置に適した状態に校正する事が可能となり、温度を適切に予想することができる。従って、熱処理のプロセスを適切に行うことができる。特に、熱処理装置の熱特性を根拠とする予想温度と実際の温度のずれを補正することが可能となる。結果として、例えば、プロセス結果が期待するものと異なり、プロセス中の温度変化が予想された変化に一致する場合には、その原因が熱以外の点にあることを容易に判別することができる。

[0013] 一実施形態において、前記処理容器は、複数の被処理体を収容可能であり、前記温度測定工程は、前記被処理体に隣接する温度センサを配置する工程と、配置した温度センサにより前記被処理体の温度を測定する工程を含む。

[0014] 一実施形態において、前記校正工程は、測定した温度と予想した温度とにに基づいて、前記予想値の補正值を求め、予想値を前記補正值により補正するように前記熱モデルを校正する。

[0015] 一実施形態において、前記加熱工程は、前記ヒータを駆動して、前記処理容器内を複数の設定温度に順次設定し、前記温度測定工程は、各設定温度での前記処理

容器内の温度を測定し、前記温度を予想する工程は、各設定温度での前記処理容器内の温度を予想し、前記校正工程は、測定した複数の温度と予想した複数の温度とに基づいて、前記予想値の補正值を求め、前記熱モデルの予想値を前記補正值により補正するように前記熱モデルを校正する。

- [0016] 一実施形態において、前記熱モデルは、前記ヒータの温度と各温度センサの温度を予想する機能を備え、前記校正工程は、前記ヒータの温度の変化量と前記温度センサの測定温度の変化量との関係と、前記ヒータに最も近接する温度センサの熱モデルによる予想温度と該温度センサの実測温度との差と、に基づいて補正值を求め、予想値を補正值に基づいて補正するように前記熱モデルを校正する。
- [0017] 一実施形態において、前記処理容器内には内部ヒータが配置されており、前記熱モデルは、前記内部ヒータの温度を予想する機能を備え、前記校正工程は、前記内部ヒータの温度の変化量と前記温度センサの測定温度の変化量との関係と、前記内部ヒータに最も近接する温度センサの熱モデルによる予想温度と該温度センサの実測温度との差と、に基づいて補正值を求め、予想値を補正值に基づいて補正するように前記熱モデルを校正する、ようにしてもよい。
- [0018] 一実施形態において、前記処理容器内に収容される被処理体の上部と下部には、それぞれ、第1と第2のヒータが配置され、前記熱モデルは、前記第1と第2のヒータの温度を予想する機能を備え、前記校正工程は、前記第1のヒータの温度の変化量と前記温度センサの測定温度の変化量との関係と、前記第1のヒータに最も近接する温度センサの熱モデルによる予想温度と該温度センサの実測温度との差と、に基づいて第1の補正值を求め、前記第2のヒータの温度の変化量と前記温度センサの測定温度の変化量との関係と、前記第2のヒータに最も近接する温度センサの熱モデルによる予想温度と該温度センサの実測温度との差と、に基づいて第2の補正值を求め、前記熱モデルによる予想値を第1と第2の補正值に基づいて補正するように前記熱モデルを校正する、ようにしてもよい。

上記構成の校正方法により校正された熱モデルを用いて処理容器内の温度を予想し、予想した温度に基づいて、被処理体に熱処理を施すようにしてもよい。

- [0019] 上記目的を達成するため、この発明の第2の観点に係る熱処理装置は、

被処理体を収容する処理容器と複数のヒータと複数の温度センサとを備え、前記温度センサの出力から前記処理容器内の被処理体の温度を推定するための熱モデルを記憶し、前記温度センサの出力から、該熱モデルを用いて、前記処理容器内の被処理体の温度を予想し、予想した温度に基づいて前記ヒータを制御することにより、前記被処理体に熱処理を施す熱処理装置であって、

前記ヒータを駆動して、前記処理容器内を加熱する手段と、

前記処理容器内の前記被処理体の温度を測定する手段と、

測定した前記処理容器内の温度と、前記熱モデルを用いて予想した前記被処理体の温度とを比較し、実測値に予想値が実質的に一致するように前記熱モデルを校正する手段と、

を備えることを特徴とする。

本発明によれば、個々の熱処理装置の熱特性に応じて、熱モデルをカスタマイズして、その装置に適合した熱モデルを生成することが可能となる。

図面の簡単な説明

[0020] [図1]本発明の実施の形態に係る熱処理装置の構成を示す図である。

[図2]図1に示す制御部の構成を示す図である。

[図3]図2に示す熱モデル記憶部とレシピ記憶部に記憶されるデータの例を示す図である。

[図4]セットアップレシピの例を示す図である。

[図5]温度測定装置の構成を示す図である。

[図6]温度測定装置の腕部をポートに挿入した状態を示す図である。

[図7]基準熱モデルを校正して校正熱モデルを生成する手順を説明するためのフローチャートである。

[図8]基準熱モデルを校正して校正熱モデルを生成する手順を説明するためのフローチャートである。

[図9]セットアップレシピによる各設定温度における、基準熱モデルによる予想温度と実測温度とを対応付けて記憶する様子を示す図である。

[図10]基準熱モデルを補正する方法を説明するための図である。

符号の説明

[0021] 1 热処理装置

11 处理容器

15 下端部

21 蓋体

24 回転テーブル

26 ボート

31 周面ヒータ

31a メインヒータ

31b 上端サブヒータ

31c 下端サブヒータ

32 上面ヒータ

33 下面ヒータ

100 制御部

S1～S5 温度センサ

TC1～TC5 热電対(温度センサ)

発明を実施するための最良の形態

[0022] 本発明のバッチ式熱処理装置を縦型熱処理装置に適用した実施の形態について説明する。

本実施の形態に係る縦型の熱処理装置1は、図1に示すように、処理容器(反応管)11を備える。処理容器11は、被処理体を成すウェハWを収容して、所定の熱処理、例えば、CVD処理を施すためのものであり、耐熱性および耐食性を有する材料例えば石英ガラスにより形成されている。処理容器11は、上端と下端が開放された単管構造を有し、上端は細径に絞られて、排気部12を形成する。排気部12は、図示せぬ排気管などを介して真空ポンプ等に接続されている。

[0023] 処理容器11の下部には、処理容器11内に処理ガスや不活性ガスを導入するガス導入部(導入ポート)13が配置されている。ガス導入部13には、ガス源に通じる一又は複数のガス供給系の配管14が挿通される。ガス導入部13から導入された処理ガ

スは、処理容器11内を上昇してウエハWの所定の熱処理に供された後、排気部12から排気される。

- [0024] 処理容器11のフランジ状に形成された下端部15は、ステンレス等の耐熱性および耐食性を有する材料から形成された蓋体21により開閉される。蓋体21は、図示せぬエレベータにより昇降し、上昇した位置で、処理容器11の下端部15を密閉し、下降した位置で、処理容器11の下端部15を開放する。処理容器11の下端部15と蓋体21との間には、気密を確保するためのOリング22が配置されている。
- [0025] 蓋体21の中央部には、回転支柱23が回転可能に立設され、回転支柱23の上端には、回転テーブル24が固定されている。また、蓋体21の下部には、回転支柱23を回転駆動する駆動部25が設けられている。
- [0026] 回転テーブル24の上には、例えば、60枚の半導体ウエハWを高さ方向に所定間隔で搭載可能な石英ガラス製のポート(ウエハポート)26が載置される。ポート26は、蓋体21が降下した状態で回転テーブル24上に載置され、蓋体21が上昇して処理容器11の下端部15を密閉すると、処理容器11内へのロードが完了し、処理完了後、蓋体21が降下することによりアンロードされる。また、プロセス中は、駆動部25による回転テーブル24の回転により回転し、ウエハWに均一な熱処理が施される。
- [0027] 処理容器11の周囲には、処理容器11内に収容されたウエハWを周縁部から加熱昇温させるための周面ヒータ31が配置されている。周面ヒータ31は、例えば棒状の抵抗発熱体から構成され、垂直状態で処理容器11の周囲を取り囲むように筒状に配設されている。周面ヒータ31は、処理容器11の周囲全体を加熱するメインヒータ31aと、処理容器11の上端側および下端側の周囲を加熱する上端サブヒータ31bと下端サブヒータ31c、から構成される。メインヒータ31aとサブヒータ31b、31cは、処理容器11の周方向に交互に配置されている。
- [0028] 処理容器11の上下には、上面ヒータ32と下面ヒータ33とが設けられている。
- [0029] 上面ヒータ32は、処理容器11の排気側の放熱によるウエハ温度の低下を防ぐためのものであり、排気部12の周囲にドーナツ状に形成され、支持部材34により支持体35に固定されている。
- [0030] また、下面ヒータ33は、蓋体21等を介した放熱によるウエハ温度の低下を防止す

るためのものであり、処理容器11内の回転テーブル24の下に位置するように、支持部材34により蓋体21上に固定されている。下面ヒータ33は、その中央部を回転支柱23が貫通するようにドーナツ状に形成されている。

- [0031] 処理容器11の外周面には、垂直方向に一列に3つの温度センサS1～S3が配置されている。温度センサS1はポート26の上部に対応する位置に、温度センサS2はポート26の中央部に対応する位置に、温度センサS3はポート26の下部に対応する位置に、それぞれ配置されている。
- [0032] また、処理容器11内の上面ヒータ32とポート26の上端面との間の位置に温度センサS4が配置され、処理容器11内の下面ヒータ33と回転テーブル24との間の位置に、温度センサS5が配置されている。温度センサS4とS5とは、金属汚染を防止するため、例えば、石英チューブに収納されている。
- [0033] 温度センサS1～S5の出力(検出温度)は、後述するように、ポート26に配置されたウェハWと上面ヒータ32および下面ヒータ33の表面温度を予想(推定；予測)するために使用される。
- [0034] 热処理装置1は、装置全体の制御を行う制御部100を備えている。
- [0035] 図2に示すように、制御部100には、温度センサS1～S5、操作パネル121、圧力計(群)122、ヒータコントローラ123、マスフローコントローラ124、弁開閉制御部125、真空ポンプ126等が接続されている。
- [0036] 温度センサS1～S5は、前述のように、処理容器11の外壁面の温度と上面ヒータ32及び下面ヒータ33近傍の温度を測定して、制御部100に通知する。
操作パネル121は、表示画面と操作ボタンとを備え、オペレータの操作指示を制御部100に伝え、また、制御部100からの様々な情報を表示画面に表示する。
圧力計(群)122は、処理容器11内及び排気部12内の各部の圧力を測定し、測定値を制御部100に通知する。
- [0037] ヒータコントローラ123は、ヒータ31a、31b、31c、32、33を個別に制御するためのものであり、制御部100からの指示に応答して、ヒータ31a、31b、31c、32、33に通電してこれらを加熱し、また、各ヒータ31a、31b、31c、32、33の消費電力を個別に測定して、制御部100に通知する。

[0038] マスフローコントローラ124は、各配管に配置され、各配管を流れるガスの流量を制御部100から指示された量に制御すると共に実際に流れたガスの流量を測定して、制御部100に通知する。

[0039] 弁開閉制御部125は、各配管に配置され、各配管に配置された弁の開度を制御部100から指示された値に制御する。真空ポンプ126は、処理容器11の排気部12に排気パイプ等を介して接続され、処理容器11内を排気する。

[0040] 制御部100は、図2に示すように、熱モデル記憶部111と、レシピ記憶部112と、ROM113と、RAM114と、I/Oポート115と、CPU116と、これらを相互に接続するバス117とから構成される。

[0041] 热モデル記憶部111には、図3(a)に示すように、この熱処理装置1と同一仕様の基準装置を用いて作成された基準熱モデルM1と、基準熱モデルM1をこの熱処理装置1用に校正(カスタマイズ)して生成された校正熱モデルM2とが記憶される。この熱処理装置1の製造当初は、基準熱モデルM1のみが熱モデル記憶部111に記憶され、熱処理装置1のセットアップ処理により校正熱モデルM2が格納される。

[0042] 基準熱モデルM1と校正熱モデルM2は、共に、温度センサS1～S5の出力信号(測定温度)及びヒータ31a～33への供給電力(ヒータ31a～33に接続されたヒータコントローラ123からの供給電力量を示す指示値)等から処理容器11内の温度を予想するためのモデル(数学モデル；高次・多次元行列)である。ただし、基準熱モデルM1は、基準装置を用いて生成されたものであり、同一仕様の複数の熱処理装置1に共通のものである。一方、校正熱モデルM2は、各熱処理装置1のセットアップ時に基準熱モデルM1を、個々の装置の熱特性を正確に反映するように校正して生成され、実際の運用(プロセス処理)に使用される。

[0043] より詳細には、基準熱モデルM1は、温度センサS1～S5の出力信号(測定温度)及びヒータ31a～33への供給電力等から、ポート26の上部に載置されているウェハ(ポート上部ウェハ)Wの中心部P1および周縁部P2の温度と、ポート26の中央部に載置されているウェハ(ポート中央部ウェハ)Wの中心部P3の温度と、ポート26の下部に載置されているウェハ(ポート下部ウェハ)Wの中心部P4および周縁部P5の温度(計5箇所の温度)と、上面ヒータ32および下面ヒータ33の表面温度と、温度セン

サS4とS5の温度と、を予想する。なお、ポート中央部ウエハWについて周縁部の温度を測定しないのは、ポート26の中央部は熱的に最も安定した領域であり、ウエハWの中心部P3と周縁部との温度差がほとんど生じないため、中心部P3の温度でポート中央部ウエハW全体の温度を代表できるからである。

- [0044] また、基準熱モデルM1は、予想した各ウエハ温度から、そのウエハ温度をレシピで規定される温度(目標値)にするために各ヒータ31a～33に供給すべき電力を求める。なお、この熱モデルを生成する手法自体は、例えば、米国特許US5, 517, 594明細書に開示されている手法を利用できる。
- [0045] また、校正熱モデルM2は、この熱処理装置1に固有の熱特性に従って正確に各部の温度を推定できるようにカスタマイズされたものである点以外は、基準熱モデルM1と同一構造である。
- [0046] レシピ記憶部112には、図3(b)に示すように、セットアップレシピR1と1又は複数のプロセスレシピR2とが記憶されている。
- [0047] この熱処理装置1の製造当初は、セットアップレシピR1のみが格納される。セットアップレシピR1は、熱処理装置1の基準熱モデルM1を校正する際に実行されるものであり、図4に示すように、時間に対して上述の5箇所P1～P5の温度を階段状に昇温することを規定する。
一方、プロセスレシピR2は、ユーザが行う熱処理(プロセス)毎に用意されるレシピである。
- [0048] 図2に示すROM113は、EEPROM、フラッシュメモリ、ハードディスクなどから構成され、CPU116の動作プログラム等を記憶する記録媒体である。RAM114は、CPU116のワークエリアなどとして機能する。
- [0049] I/Oポート115は、前述の温度センサS1～S5、操作パネル121、圧力計122、ヒータコントローラ123、マスフローコントローラ124、弁開閉制御部125に接続され、データや信号の入出力を制御する。
- [0050] バス117は、各部の間で情報を伝達する。
- [0051] CPU(Central Processing Unit)116は、制御部100の中枢を構成し、ROM113に記憶された制御プログラムを実行し、操作パネル121からの指示に従って、レシピ記

憶部112に記憶されているレシピに沿って、熱処理装置1の動作を制御する。

[0052] 次に、熱処理装置1のセットアップ動作で使用する温度測定装置51について説明する。

この温度測定装置51は、図5に示すように、支柱52と、支柱52から水平方向に伸びる第1、第2および第3の腕53、54、55とを備える。第1～第3の腕53、54、55は、図6に示すように、ポート26の上部スロット、中央部スロット、下部スロットに側方から挿入可能な位置に配置されている。さらに、第1～第3の腕53～55には、熱電対(温度センサ)TC1～TC5が配置されている。

[0053] 第1の腕53には、ポート26に挿入された際に、ポート26の上部スロットのウェハWの中央部P1とエッジ部P2にそれぞれ対向する位置に熱電対TC1とTC2が配置されている。

[0054] 第2の腕54には、ポート26に挿入された際に、ポート26の中央部スロットのウェハWの中央部P3に対向する位置に熱電対TC3が配置されている。

第3の腕55には、ポート26に挿入された際に、ポート26の下部スロットのウェハWの中央部P4とエッジ部P5とにそれぞれ対向する位置に熱電対TC4とTC5が配置されている。

[0055] 热電対TC1からTC5は、各温度モニタウェハ(ポート上部スロットウェハ、ポート中央部スロットウェハ、ポート下部スロットウェハ)Wに非接触で近接して配置され、温度測定対象ウェハWの領域P1～P5の表面温度をほぼ正確に測定可能である。これらの熱電対TCの出力信号線は、セットアップ時に制御部100のI/Oポート115に接続される。

[0056] 次に、熱処理装置1のセットアップ動作について、図7と図8のフローチャートを参照して説明する。このセットアップ動作は、個々の熱処理装置1と基準装置との微妙な差異に基づく熱特性の差を求めて、熱モデル記憶部111に記憶されている基準熱モデルM1をこの熱処理装置1に固有の校正熱モデルM2に校正する作業である。

[0057] まず、操作者は、蓋体21を降下させ、回転テーブル24上に、ダミーウェハWを搭載したポート26を配置する。また、温度測定装置51を側方からポート26に挿入する。次に、蓋体21を上昇して、ポート26を処理容器11内にロードする。

[0058] 続いて、操作者は、操作パネル121から、基準熱モデルM1の校正処理の開始を指示する。

この指示に応答し、制御部100(そのCPU116)は、ROM113に記憶されている校正処理用プログラムに従って動作を開始する。

[0059] まず、制御部100は、弁開閉制御部125、真空ポンプ126等を制御し、圧力計122の出力をモニタして、処理容器11内を所定圧力まで減圧する(ステップS11)。

[0060] 続いて、処理容器11内のウェハWの領域P1～P5の温度を、セットアップレシピR1に従って、第1の温度(例えば、400°C)に設定する(ステップS12)。

[0061] ウェハWの温度が安定した時点で、熱電対TC1～TC5で各温度モニタウェハWの中央及び周縁部の位置P1～P5の温度を実測する(ステップS13)。一方、基準熱モデルM1を用いて、温度モニタウェハWの中央及び周縁部の位置P1～P5の温度を予想する(ステップS14)。

次に、実測値と予想値とを対応付けてRAM114に記憶する(ステップS15)。

[0062] 次に、セットアップレシピR1で設定されている全ての温度についての処理が終了したか否かを判断する(ステップS16)。終了していない、即ち、設定していない温度が存在する場合には(ステップS16;No)、ステップS12に戻って、次の設定温度について同様の処理を繰り返す。

[0063] 一方、セットアップレシピR1で設定されている全ての温度についての処理が終了した場合には(ステップS16;Yes)、図9に示すような実測温度と予想温度との対応表がRAM114上に完成しており、処理は、ステップS18に進む。

[0064] ステップS18においては、RAM114上に形成された対応表に基づいて、熱電対TC1～TC5で実測された温度TR1～TR5と、基準熱モデルM1により予想した温度TP1～TP5とをそれぞれ比較し、ウェハWの温度の補正值を求める。

[0065] 補正值を求める手法自体は任意であるが、例えば、下記式1に従って、補正值を求めることができる。

[数1]

$$\text{補正值 } i = \text{基準熱モデルM1による予想値 } TP_i - \text{実測値 } TR_i$$

i : 温度の予想エリア (P1～P5) を示す 1～5 の値

[0066] なお、補正值*i*は、固定値でもよく、或いは、関数の形式となつてもよい。例えば、予想値TP*i*—実測値TR*i*が、図9に示すようにばらついた場合には、例えば、最小二乗法を用いて、これらを代表する一次関数f(T) (Tは基準熱モデルM1による予想温度)を求め、これを補正值としてもよい。

[0067] 次に、基準熱モデルM1を校正する(ステップS19)。即ち、数式2の示す値が予想値となるように、基準熱モデルM1を補正する。

[数2]

$$\text{予想温度 } i = \text{基準熱モデルM1で予想した温度 } i - \text{補正值 } i$$

[0068] 例えば、補正值が図10に示すような関数f(T)で表され、基準熱モデルM1で予想した温度がT0とすると、予想温度がT0-f(T0)となるように、基準熱モデルM1を補正する。

[0069] 次に、処理容器11内の上面ヒータ32と下面ヒータ33の表面温度を正確に予想できるように、基準熱モデルM1を補正する(ステップS20)。この補正動作を図8を参照して説明する。

まず、処理容器11内の温度を所定の一定値T_{cons}に維持するように制御し、系が安定するのを待つ。次に、更新前の基準熱モデルM1を用いて、温度センサS4とS5の温度を予想する。また、温度センサS4とS5の測定値を求める(ステップS21)。

[0070] 次に、温度センサS4とS5の温度の予想値と実測値とを比較し、補正值を数式1と同様にして求める(ステップS22)。

[0071] 次に、上面ヒータ32については、ヒータコントローラ123を含めたシステムモデルより、上面ヒータ32の表面温度の変化量ΔT_tとセンサS1—S5の温度の変化量ΔT_{s1}—ΔT_{s5}との相関関係を求める(ステップS23)。

即ち、数式4を成立させる行列K_t(数式3)を求める。

[数3]

$$K_t = [K_{t1} \ K_{t2} \ K_{t3} \ K_{t4} \ K_{t5}]$$

[数4]

$$\Delta T_t = [Kt1 \ Kt2 \ Kt3 \ Kt4 \ Kt5] \cdot \begin{matrix} \overbrace{\Delta Ts1} \\ \Delta Ts2 \\ \Delta Ts3 \\ \Delta Ts4 \\ \Delta Ts5 \end{matrix}$$

[0072] 次に、下面ヒータ33については、ヒータコントローラ123を含めたシステムモデルより、下面ヒータ33の表面温度の変化量 ΔTb とセンサS1～S5の温度の変化量 $\Delta Ts1$ ～ $\Delta Ts5$ との相関関係を求める(ステップS23)。
即ち、数式6を成立させる行列 Kb (数式5)を求める。

[数5]

$$Kb = [Kb1 \ Kb2 \ Kb3 \ Kb4 \ Kb5]$$

[数6]

$$\Delta Tb = [Kb1 \ Kb2 \ Kb3 \ Kb4 \ Kb5] \cdot \begin{matrix} \overbrace{\Delta Ts1} \\ \Delta Ts2 \\ \Delta Ts3 \\ \Delta Ts4 \\ \Delta Ts5 \end{matrix}$$

[0073] 次に、この相関関係を、基準熱モデルM1の上面ヒータ32の温度を予想する部分と下面ヒータ33の温度を予想する部分とに適用し、数式7と数式8で示すように、基準熱モデルM1を校正する(ステップS24)。

[数7]

上面ヒータ32の温度=基準熱モデルM1により予想した温度 +

[Kt1 Kt2 Kt3 Kt4 Kt5] •

温度センサS4の予想温度 - 温度センサS4の測定温度
0

[数8]

下面ヒータ33の温度=基準熱モデルM1により予想した温度 +

[Kb1 Kb2 Kb3 Kb4 Kb5] •

温度センサS5の予想温度 - 温度センサS5の測定温度
0

- [0074] 以上で、基準熱モデルM1をこの装置用に校正(カスタマイズ)する処理が終了する。ロードされたポート26等は、アンロードされる。
- [0075] カスタマイズされた基準熱モデルM1、即ち、校正熱モデルM2は、熱モデル記憶部111に記憶され(ステップS25)、以後の、ウェハWの位置P1～P5の温度及び上面ヒータ32及び下面ヒータ33の表面温度の予想に使用される。
- [0076] セットアップされた熱処理装置1により、プロセスを行う場合には、実行するプロセスに応じたプロセスレシピR2がレシピ記憶部112に格納される。続いて、校正熱モデルM2を用いて、ウェハW及び上面・下面ヒータ32, 33の温度を予想しながら、プロセスを進める。このとき、校正熱モデルM2は、この熱処理装置1用に校正されたものであるので、正確にウェハWやヒータ32, 33の温度を予想することができる。また、プロセスの結果が許容範囲以下のレベルになった場合には、その原因が熱によるものであるか、他の要因によるものであるかを容易に識別することができる。
- [0077] なお、この発明は、上記実施の形態に限定されず、種々の変形及び応用が可能である。例えば、上面ヒータ32及び下面ヒータ33の温度を、例えば、放射温度計等を使用して測定し、基準熱モデルM1による予想値と放射温度計による実測値とに基

づいて、補正值を求め、この補正值から予想温度を補正するようにしてもよい。

[0078] さらに、温度予想用の温度センサの数や配置位置は、適宜変更可能であり、数は5つに限定されず、配置位置は、処理容器11の内壁に配置する等してもよい。

[0079] また、この発明を適用する熱処理装置1も、上記実施の形態のものに限定されず、任意に変更可能であり、例えば、処理容器11が例えば二重管構造であったり、ポート26に収容できる半導体ウェハWの数がより大容量(例えば、約100枚から150枚)であったり、さらには、より小容量(例えば、15ー30枚)であってもよい。

[0080] また、上記実施の形態では、CVD装置を例にこの発明を説明したが、処理の種類は任意であり、この発明は、CVD装置に限らず、酸化装置、エッチング装置、等の様々なバッチ式熱処理装置に適用可能である。

[0081] また、機器構成や動作も上記実施の形態に限定されない。例えば、上記実施の形態では、側面ヒータの数を3つ、内部ヒータの数を2つとしたが、ヒータの数や配置は任意である。また、ヒータは、電気抵抗型のものに限定されず、ランプなどでもよい。また、ウェハ等の温度を測定するための構成も熱電対に限定されず、任意の温度センサを適用可能である。

[0082] また、熱モデルやその設計手法も、米国特許5, 517, 594号公報に開示されたモデルやその設計手法に限定されるものではなく、任意のモデル及び任意の設計手法を採用可能である。

[0083] なお、上述の校正処理を行うためのコンピュータプログラムの少なくとも一部をCD-ROMやDVD-ROMなどのコンピュータ読み取り可能な記録媒体に格納して配布し、I/Oポート115を介してRAM114に転送し、転送したプログラムをCPU116で実行することにより、上述の校正処理を実行するようにしてもよい。また、プログラムをネットワークを介してI/Oポート115に転送するようにしてもよい。

請求の範囲

[1] 被処理体を収容する処理容器と複数のヒータと複数の温度センサとを備え、前記温度センサの出力から前記処理容器内の被処理体の温度を推定するための熱モデルを記憶し、前記温度センサの出力から、該熱モデルを用いて、前記処理容器内の被処理体の温度を予想し、予想した温度に基づいて前記ヒータを制御することにより、前記被処理体に熱処理を施す熱処理装置の校正方法であって、
前記ヒータを駆動して、前記処理容器内を加熱する工程と、
前記処理容器内の前記被処理体の温度を測定する工程と、
測定した前記処理容器内の温度と、前記熱モデルを用いて予想した前記被処理体の温度とを比較し、実測値に予想値が実質的に一致するように前記熱モデルを校正する工程と、
を備えることを特徴とする熱処理装置の校正方法。

[2] 前記処理容器は、複数の被処理体を収容可能であり、
前記温度測定工程は、前記被処理体に隣接する温度センサを配置する工程と、
配置した温度センサにより前記被処理体の温度を測定する工程を含む、
ことを特徴とする請求項1に記載の熱処理装置の校正方法。

[3] 前記校正工程は、測定した温度と予想した温度とにに基づいて、前記予想値の補正值を求め、予想値を前記補正值により補正するように前記熱モデルを校正することを特徴とする請求項1又は2に記載の熱処理装置の校正方法。

[4] 前記加熱工程は、前記ヒータを駆動して、前記処理容器内を複数の設定温度に順次設定し、
前記温度測定工程は、各設定温度での前記処理容器内の温度を測定し、
被処理体の温度を予想する工程は、各設定温度での前記処理容器内の温度を予想し、
前記校正工程は、測定した複数の温度と予想した複数の温度とにに基づいて、前記予想値の補正值を求め、前記熱モデルの予想値を前記補正值により補正するように前記熱モデルを校正する、
ことを特徴とする請求項1又は2に記載の熱処理装置の校正方法。

[5] 前記熱モデルは、前記ヒータの温度と各温度センサの温度を予想する機能を備え、
前記校正工程は、前記ヒータの温度の変化量と前記温度センサの測定温度の変化量との関係と、前記ヒータに最も近接する温度センサの熱モデルによる予想温度と該温度センサの実測温度との差と、に基づいて補正值を求め、予想値を補正值に基づいて補正するように前記熱モデルを校正する、
ことを特徴とする請求項1乃至4のいずれか1項に記載の熱処理装置の校正方法。

[6] 前記処理容器内には内部ヒータが配置されており、
前記熱モデルは、前記内部ヒータの温度を予想する機能を備え、
前記校正工程は、前記内部ヒータの温度の変化量と前記温度センサの測定温度の変化量との関係と、前記内部ヒータに最も近接する温度センサの熱モデルによる予想温度と該温度センサの実測温度との差と、に基づいて補正值を求め、予想値を補正值に基づいて補正するように前記熱モデルを校正する、
ことを特徴とする請求項1乃至4のいずれか1項に記載の熱処理装置の校正方法。

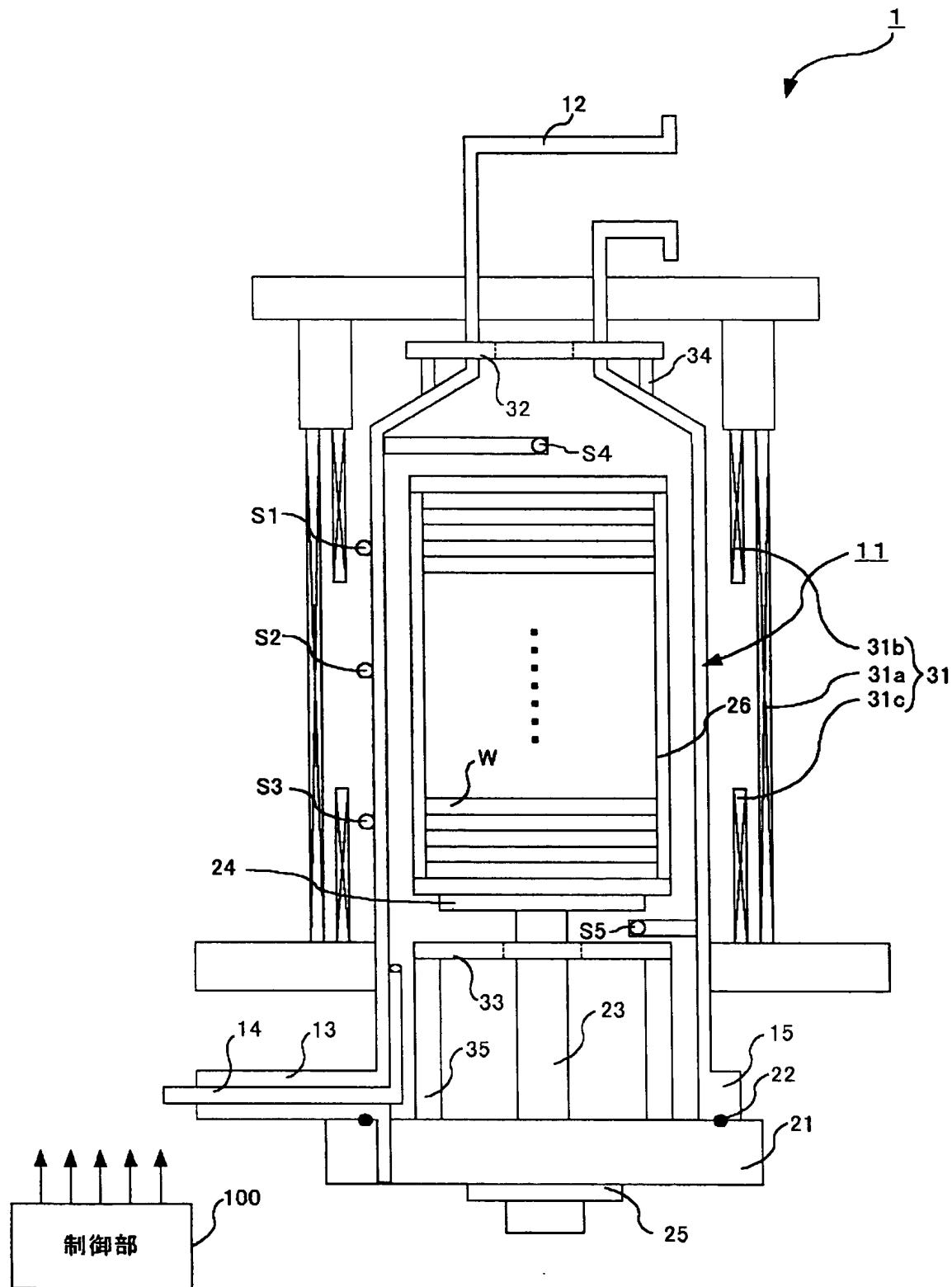
[7] 前記処理容器内に収容される被処理体の上部と下部には、それぞれ、第1と第2のヒータが配置されており、
前記熱モデルは、前記第1と第2のヒータの温度を予想する機能を備え、
前記校正工程は、前記第1のヒータの温度の変化量と前記温度センサの測定温度の変化量との関係と、前記第1のヒータに最も近接する温度センサの熱モデルによる予想温度と該温度センサの実測温度との差と、に基づいて第1の補正值を求め、前記第2のヒータの温度の変化量と前記温度センサの測定温度の変化量との関係と、前記第2のヒータに最も近接する温度センサの熱モデルによる予想温度と該温度センサの実測温度との差と、に基づいて第2の補正值を求め、
前記熱モデルによる予想値を第1と第2の補正值に基づいて補正するように前記熱モデルを校正する、
ことを特徴とする請求項1乃至4のいずれか1項に記載の熱処理装置の校正方法。

[8] 請求項1乃至7のいずれか1項に記載の熱処理装置の校正方法により校正された熱モデルを用いて処理容器内の温度を予想し、予想した温度に基づいて、被処理

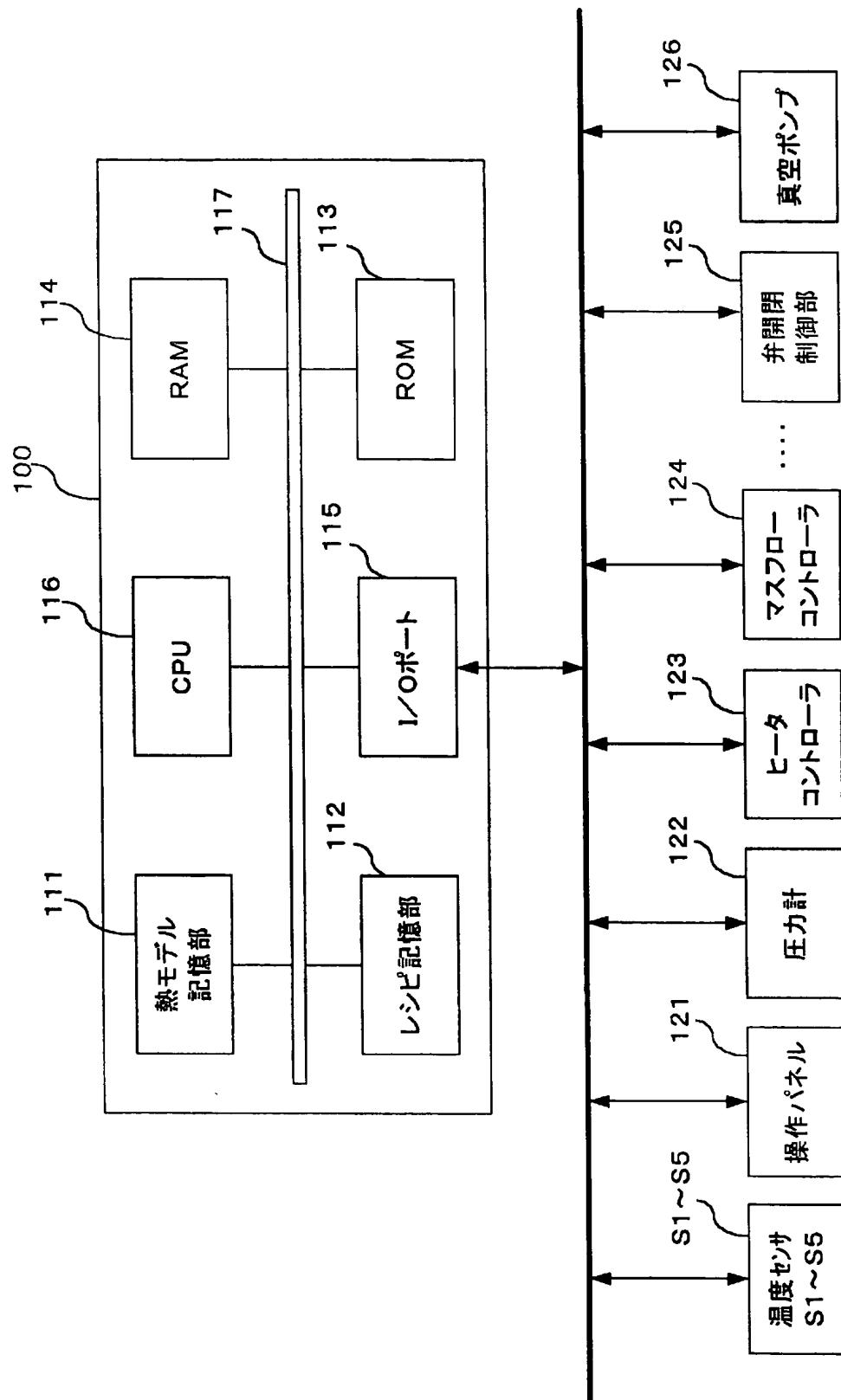
体に熱処理を施す工程をさらに備えることを特徴とする熱処理方法。

[9] 被処理体を収容する処理容器と複数のヒータと複数の温度センサとを備え、前記温度センサの出力から前記処理容器内の被処理体の温度を推定するための熱モデルを記憶し、前記温度センサの出力から、該熱モデルを用いて、前記処理容器内の被処理体の温度を予想し、予想した温度に基づいて前記ヒータを制御することにより、前記被処理体に熱処理を施す熱処理装置であって、
前記ヒータを駆動して、前記処理容器内を加熱する手段と、
前記処理容器内の前記被処理体の温度を測定する手段と、
測定した前記処理容器内の温度と、前記熱モデルを用いて予想した前記被処理体の温度とを比較し、実測値に予想値が実質的に一致するように前記熱モデルを校正する手段と、
を備えることを特徴とする熱処理装置。

[図1]

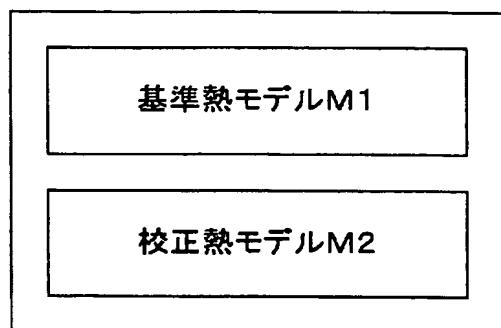


[図2]



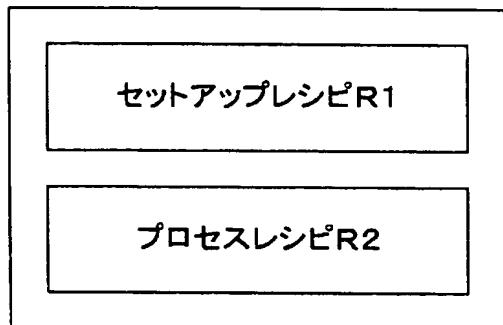
[図3]

111 热モデル記憶部



(a)

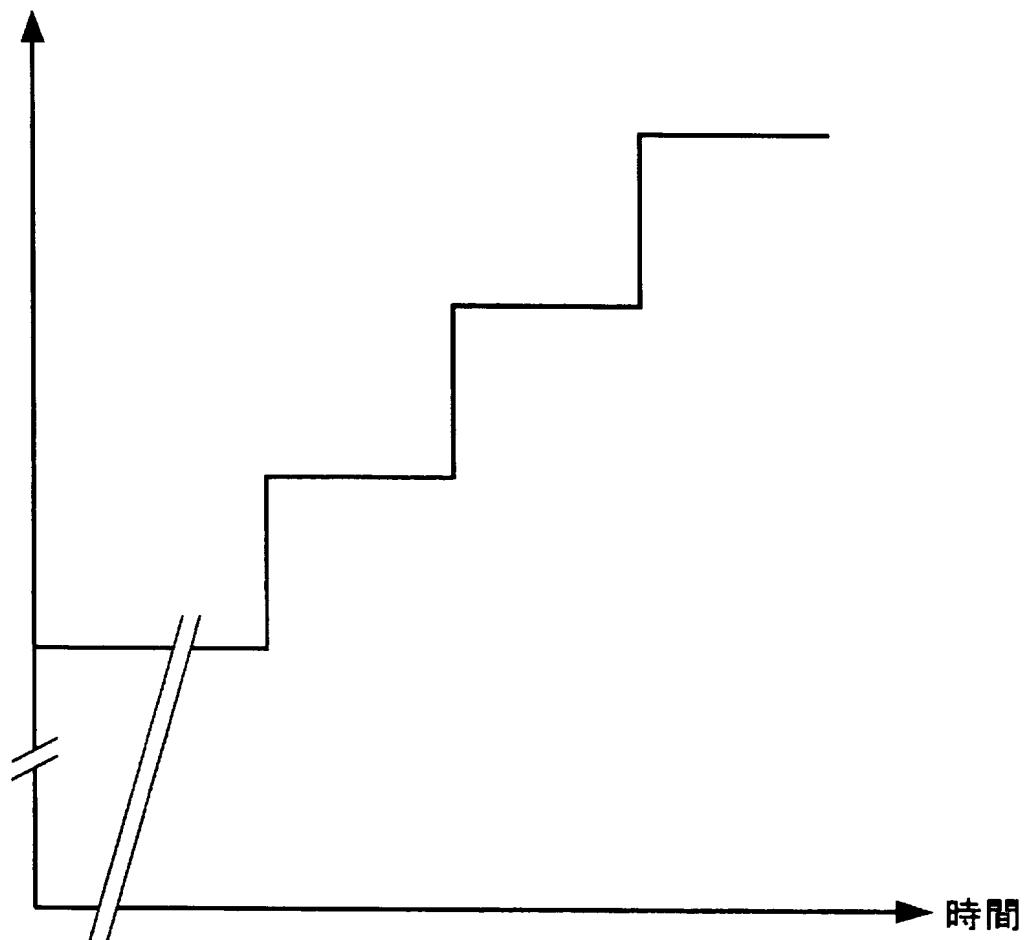
112 レシピ記憶部



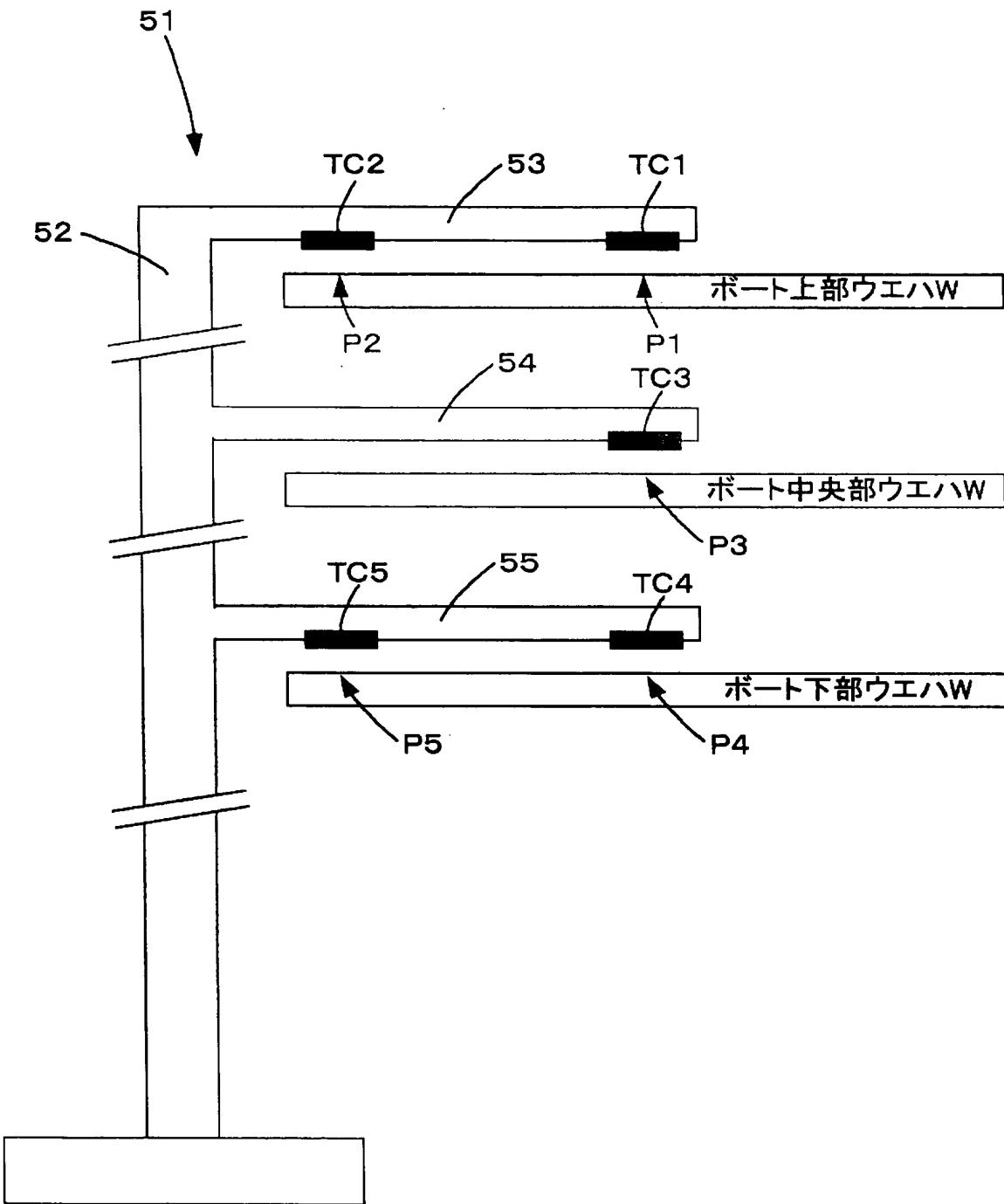
(b)

[図4]

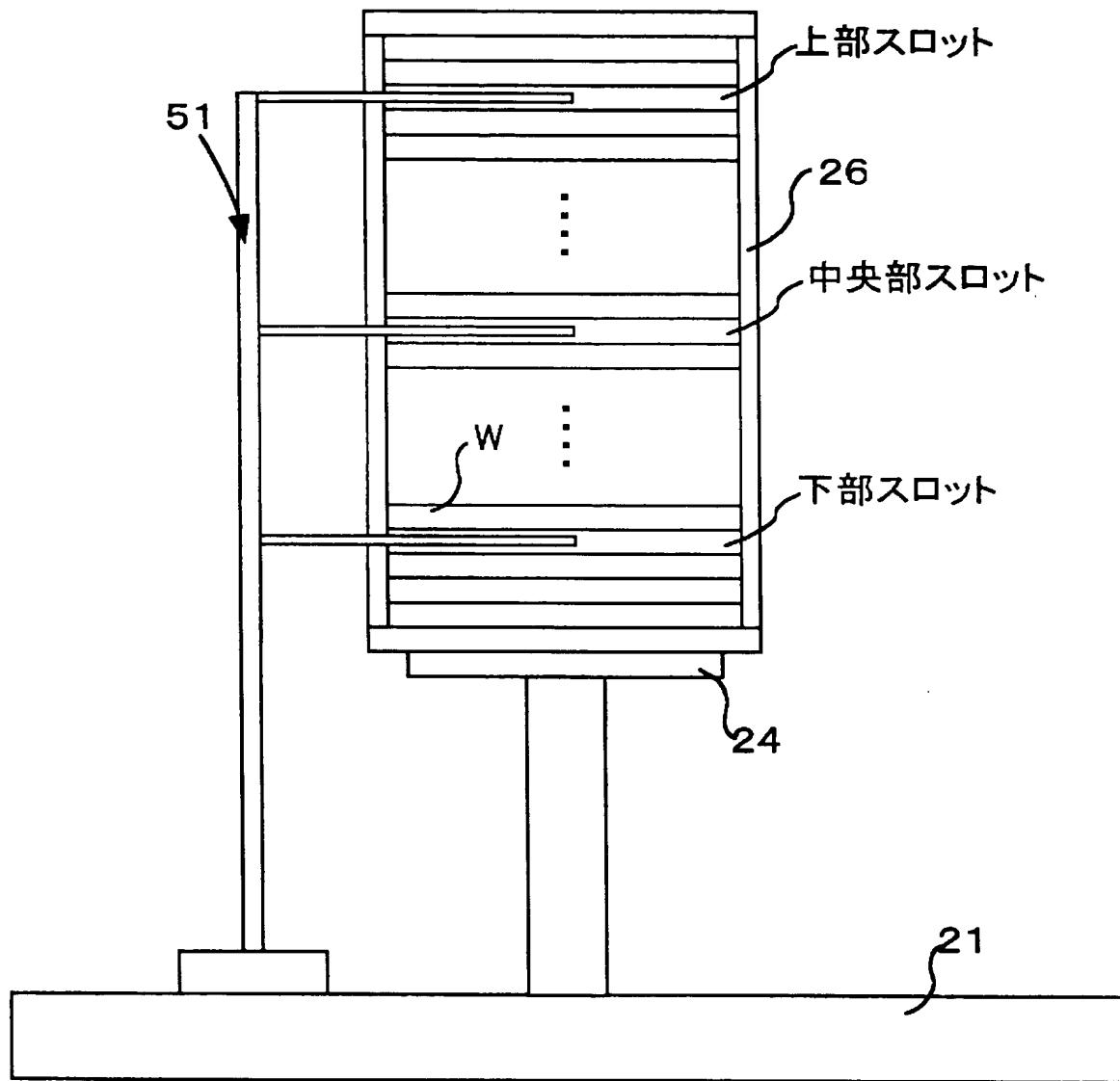
温度



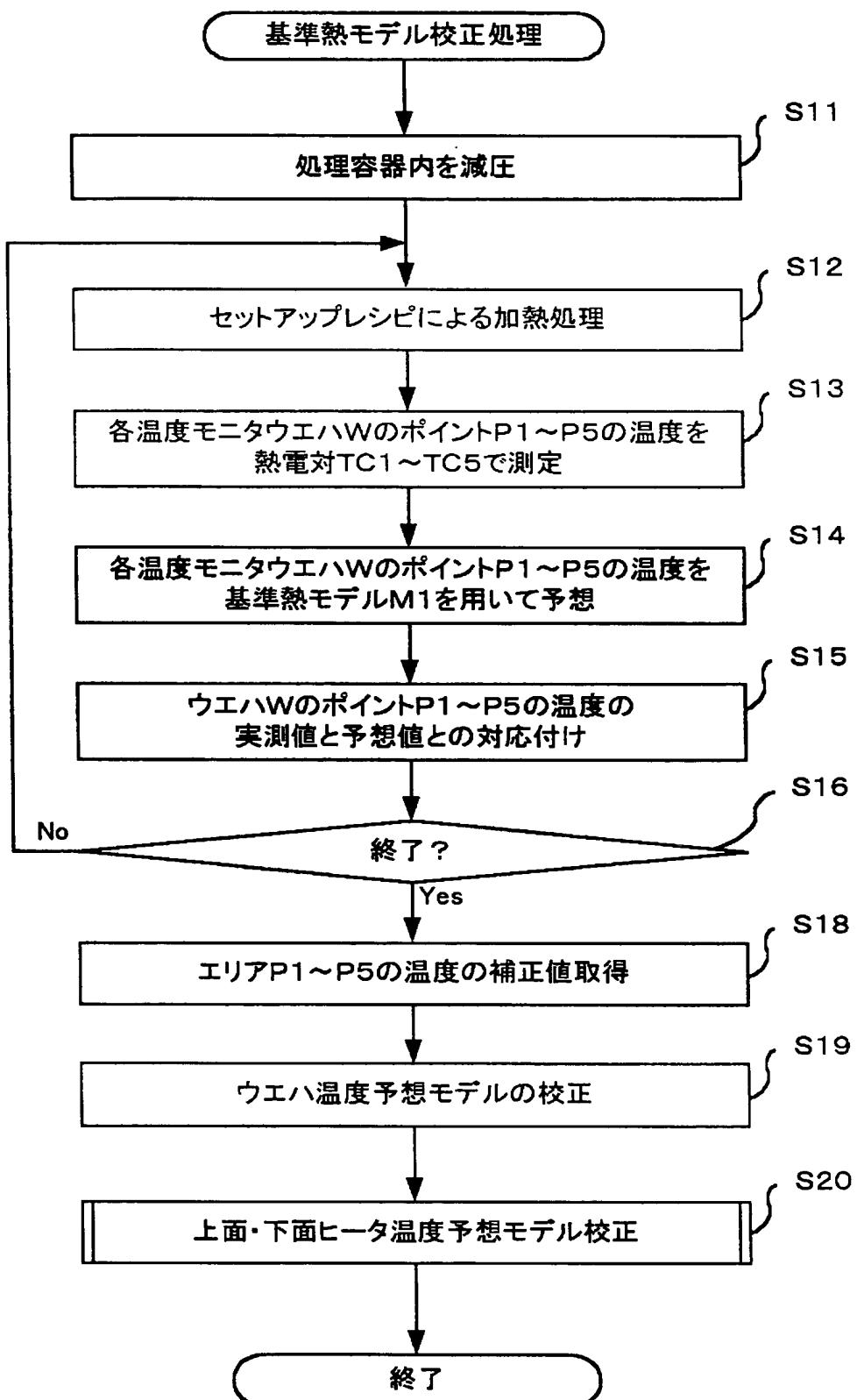
[図5]



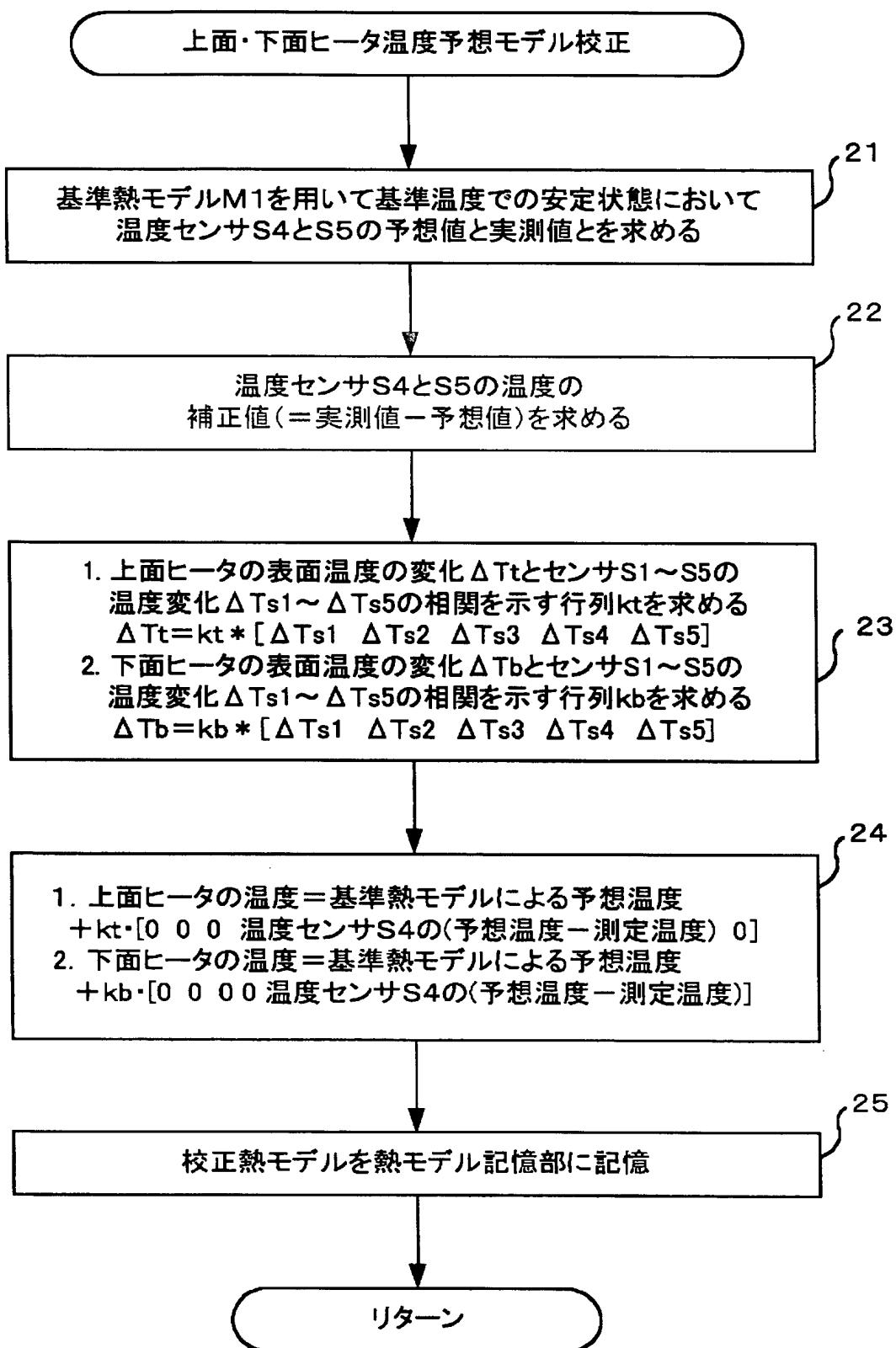
[図6]



[図7]



[図8]

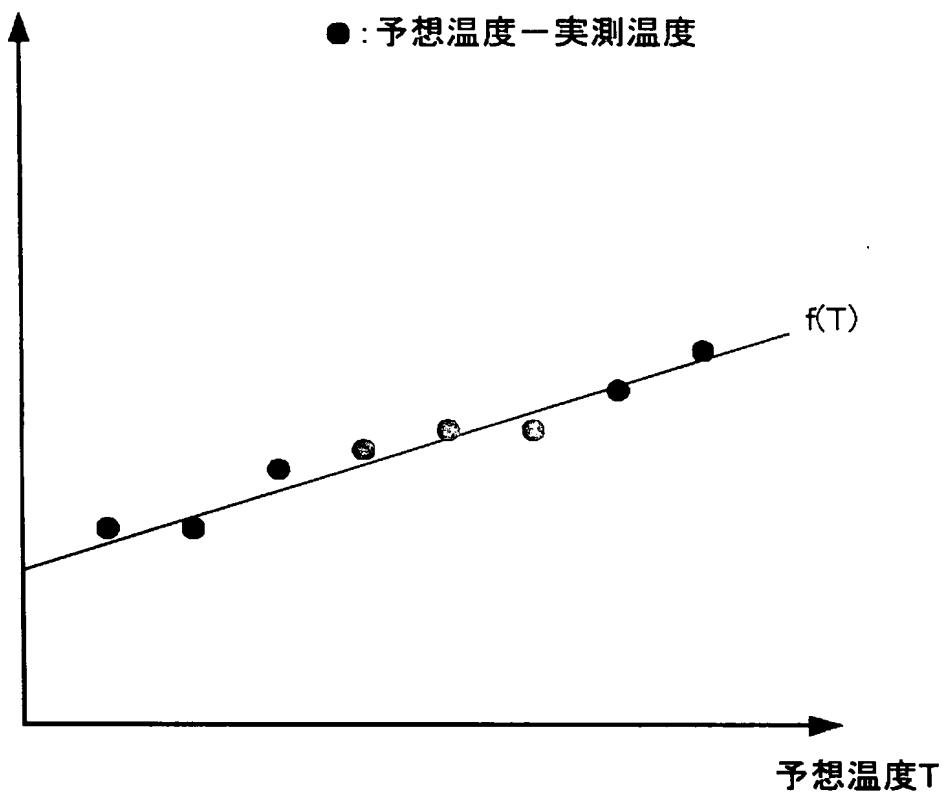


[図9]

設定(目標時)温度	実測温度					予想温度				
	TC1	TC2	TC3	TC4	TC5	TP1	TP2	TP3	TP4	TP5
500°C	490°C	480°C	490°C	490°C	480°C	500°C	500°C	500°C	500°C	500°C
600°C	587°C	570°C	590°C	590°C	585°C	600°C	600°C	600°C	600°C	600°C
.....
1100°C	1090°C	1070°C	1086°C	1090°C	1080°C	1080°C	1100°C	1100°C	1100°C	1100°C

[図10]

予想温度と実測温度の差



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2004/009326

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
 Int.C1⁷ H01L21/205, H01L21/31, H01L21/22

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int.C1⁷ H01L21/205, H01L21/31, H01L21/22

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched
 Jitsuyo Shinan Koho 1922-1996 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2004
 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2004 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2004

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	JP 2002-141347 A (Tokyo Electron Ltd.), 17 May, 2002 (17.05.02), Full text (Family: none)	1-4, 8, 9
X	JP 2002-025997 A (Tokyo Electron Ltd.), 25 January, 2002 (25.01.02), Full text & US 2002/0014483 A1	1-4, 8, 9
A	JP 2002-124481 A (Hitachi Kokusai Electric Inc.), 26 April, 2002 (26.04.02), Full text (Family: none)	1-9

 Further documents are listed in the continuation of Box C. See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search
 15 September, 2004 (15.09.04)

Date of mailing of the international search report
 05 October, 2004 (05.10.04)

Name and mailing address of the ISA/
 Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

A. 発明の属する分野の分類（国際特許分類（IPC））

Int.Cl' H01L21/205, H01L21/31, H01L21/22

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料（国際特許分類（IPC））

Int.Cl' H01L21/205, H01L21/31, H01L21/22

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報	1922-1996年
日本国公開実用新案公報	1971-2004年
日本国登録実用新案公報	1994-2004年
日本国実用新案登録公報	1996-2004年

国際調査で使用した電子データベース（データベースの名称、調査に使用した用語）

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X	JP 2002-141347 A (東京エレクトロン株式会社) 2002.05.17, 全文, (ファミリーなし)	1-4, 8, 9
X	JP 2002-025997 A (東京エレクトロン株式会社) 2002.01.25, 全文, & US 2002/0014483 A1	1-4, 8, 9
A	JP 2002-124481 A (株式会社日立国際電気) 2002.04.26, 全文, (ファミリーなし)	1-9

 C欄の続きにも文献が列挙されている。 パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの

「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの

「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献（理由を付す）

「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献

「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの

「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの

「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの

「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

15. 09. 2004

国際調査報告の発送日

05.10.2004

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/JP)

郵便番号100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官（権限のある職員）

池淵 立

4R 8831

電話番号 03-3581-1101 内線 3469